

7素子シリコンドリフト検出器システム

多素子化と最適DSP処理により高計数、高感度を実現

日本製

システム

20190607

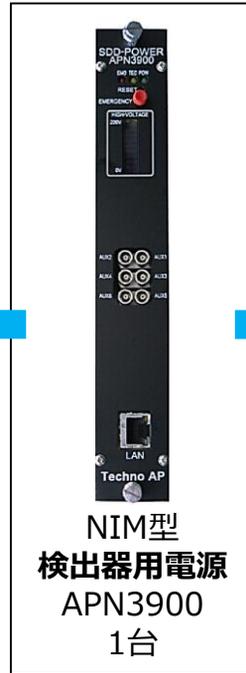
材料分野の構造解析などで用いられているX線吸収微細構造測定に必要なシリコンドリフト検出器、データ計測ボード、検出器用電源が一つになりました。高い計数率とエネルギー分解能を有したシリコンドリフト検出器を多素子化し高感度化を実現しました。また、トランジスタリセット処理とDSP処理を適切に行うことで高計数測定が可能です。

- 全有感面積 350mm²
(collimated to 50mm²×7素子)
- 全素子面積 455mm²
(65mm²×7素子)

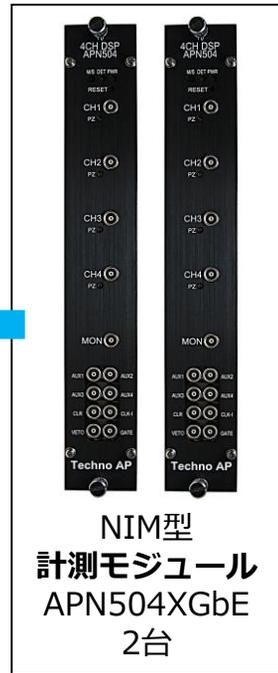
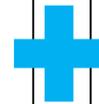


シリコンドリフト検出器
XSDD50-07BE
1台

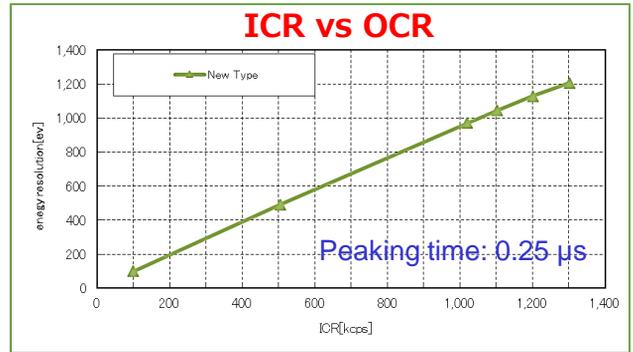
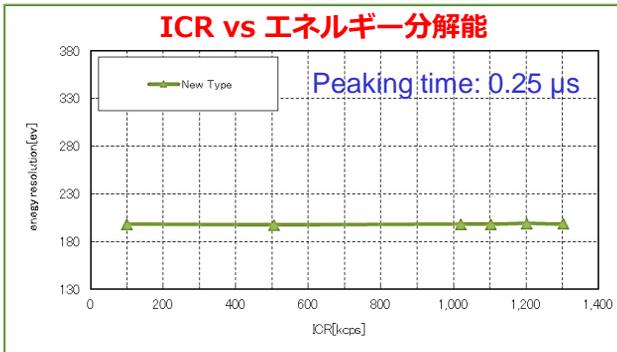
検出器背面



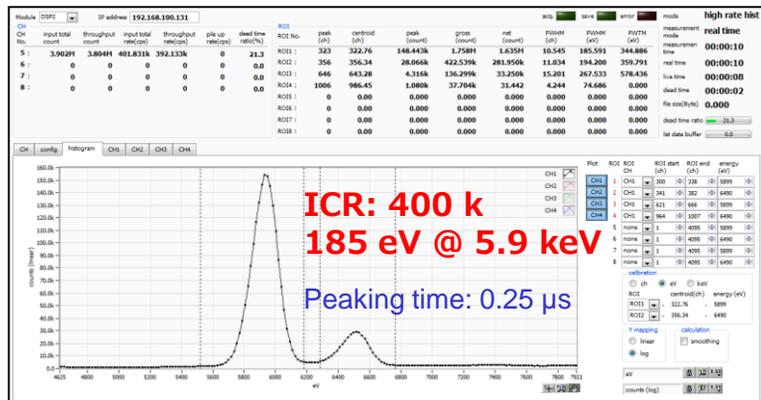
NIM型
検出器用電源
APN3900
1台



NIM型
計測モジュール
APN504XGbE
2台



機能	ヒストグラム、リスト、 波形、ROI-SCA
エネルギー分解能	244 eV @ 5.9 keV MnKa (OCR: 1000 k, Peaking time: 0.25μs)
ADC	100 MHz, 14-bit
SDD用電源	-200V、±5V、+3.3V
通信	イーサネット (TCP/IP)
付属	アプリケーションソフトウェア 取扱説明書



データ収集用アプリケーション画面

弊社ホームページ

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。



放射線・放射能測定装置 ◆設計・開発・販売◆
株式会社 テクノエーピー
〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

☎ 029-350-8011

☎ 029-352-9013

✉ order@techno-ap.com